

	<p><b>SI2323CDS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2323CDS-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2323CDS-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 216711 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2323CDS-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	216711 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta), 2.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 4.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1090pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®

SI2323CDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2323CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2323CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2323CDS-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2323</b> GMC SI2323 GMC</p>	 <p><b>SI2323CDS-T1</b> VISHAY SI2323CDS-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI2321DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.9A SOT-23</p>	 <p><b>SI2323CDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23</p>
 <p><b>SI2323CDS-T1-E3</b> VISHAY SI2323CDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI2323DDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A SOT-23</p>	 <p><b>SI2323DDS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A SOT-23</p>	 <p><b>SI2323DDS-T1-E3</b> Son SI2323DDS-T1-E3 Son</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2318DS-T1-E3	 SI2318DS-T1-E3	 SI2318DS-T1-GE3	 SI2318DS-T1-GE3	 SI2319ADS-T1-GE3
 SI2319C95TF	 SI2319CDS-T1-E3	 SI2319CDS-T1-GE3	 SI2319CDS-T1-GE3	 SI2319DDS-T1-GE3
 SI2319DS	 SI2319DS-T1-E3	 SI2319DS-T1-E3	 SI2319DS-T1-GE3	 SI2319DS-T1-GE3
 SI2320DS	 SI2320DS-T1-E3	 SI2320DS-T1-GE3	 SI2321DS-T1-E3	 SI2321DS-T1-E3
 SI2321DS-T1-GE3	 SI2321DS-T1-GE3	 SI2323CDS-T1	 SI2323CDS-T1-E3	 SI2323CDS-T1-GE3
 SI2323DDS-T1-E3	 SI2323DDS-T1-GE3	 SI2323DDS-T1-GE3	 SI2323DS	 SI2323DS-T1-E3
 SI2323DS-T1-E3	 SI2323DS-T1-GE3	 SI2323DS-T1-GE3	 SI2324DS-T1-E3	 SI2324DS-T1-GE3
 SI2324DS-T1-GE3	 SI2325DS-T1-E3	 SI2325DS-T1-E3	 SI2325DS-T1-GE3	 SI2325DS-T1-GE3
 SI2327DS-T1-E3	 SI2327DS-T1-E3	 SI2327DS-T1-GE3	 SI2327DS-T1-GE3	 SI2328DS
 SI2328DS-T1	 SI2328DS-T1-E3	 SI2328DS-T1-E3	 SI2328DS-T1-GE3	 SI2328DS-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited